

2(К)Т682А(Б)-2

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарной структуры n-p-n усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 3,6 ГГц.

Предназначены для применения в малошумящих усилителях с расширенным динамическим диапазоном в составе гибридных интегральных микросхем, микросборок.

Транзисторы 2Т682А-2, 2Т682Б-2, КТ682А-2, КТ682Б-2 бескорпусные на металлокерамическом кристаллодержателе с гибкими полосковыми выводами.

Транзисторы маркируются цветными точками:

- КТ682А-2 - одна зеленая,
- КТ682Б-2 - две зеленые,
- 2Т682А-2 - знаком «V» синего цвета у базового вывода,
- 2Т682Б-2 - знаком «V» черного цвета у базового вывода.

Тип прибора указывается в этикетке. Масса транзистора не более 0,13.

Тип корпуса: КТ-22. Технические условия: АА0.339.663 ТУ.

Технические характеристики транзисторов 2Т682А-2, 2Т682Б-2, КТ682А-2, КТ682Б-2:

Тип транзистора	Структура	Предельные значения параметров при Tп=25°C							Значения параметров при Tп=25°C						Tп max	T max	
		Ik max	Ik. и. max	UкЭR max (UкЭ0 max)	UкБ0 max	UЭБ0 max	UПИТ max	Рк. т. max	h21Э	UкЭ нас.	IkБ0	IЭБ0	f гр.	РВЫХ			КУР
		мА	мА	В	В	В	В	мВт		В	мкА	мкА	ГГц	Вт			дБ
2Т682А-2	n-p-n	50	-	-	10	1	-	0,33	40...75	-	<1	<20	>4,4	-	>7	150	-60...+125
2Т682Б-2	n-p-n	50	-	-	10	1	-	0,33	80...120	-	<1	<20	>4,4	-	>7	150	-60...+125
КТ682А-2	n-p-n	50	-	-	10	1	-	0,33	40...75	-	<1	<20	>4,4	-	>7	150	-60...+125
КТ682Б-2	n-p-n	50	-	-	10	1	-	0,33	80...120	-	<1	<20	>4,4	-	>7	150	-60...+125

Условные обозначения электрических параметров транзисторов:

- **Ik max** - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
- **Ik. и. max** - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
- **UкЭR max** - максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- **UкЭ0 max** - максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при токе базы, равном нулю.
- **UкБ0 max** - максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база при токе эмиттера, равном нулю.
- **UЭБ0 max** - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
- **UПИТ max** - максимально допустимое напряжение питания.
- **Рк.ср. max** - максимально допустимая средняя мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- **Рк. т. max** - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора с теплоотводом.
- **h21Э** - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
- **UкЭ нас.** - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
- **IkЭR** - обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- **IkБ0** - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
- **IЭБ0** - обратный ток эмиттера. Ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора.
- **f гр** - граничная частота коэффициента передачи тока.
- **РВЫХ** - выходная мощность транзистора.
- **КУР** - коэффициент усиления по мощности транзистора.
- **Tп max** - максимально допустимая температура перехода.
- **T max** - максимально допустимая температура окружающей среды.